

[SK하이닉스] HBM4 양산 임박! SK하이닉스, 차세대 반도체 투자 확대(2024년_4Q)

종목명 : SK하이닉스(000660)

컨콜일 : 25년 1월 셋째주

Key points

📌 핵심 결론

- 2024년 창사 이래 최대 실적을 달성했으며, HBM 중심의 수익성 개선과 HBM4 양산 로드맵, CAPEX 확대를 통해 AI 메모리 리더십을 강화하고 있음.

NEW 이번 콜 신규 업데이트 포인트

- HBM4(12단) 2025년 하반기 양산, 16단은 2026년 양산 예상
- 2025년 CAPEX는 HBM·M15X·용인 팹 등 인프라 중심으로 전년 대비 증가
- 1c 나노(6세대) 개발 완료, 속도 28%·전력 효율 9% 이상 개선

1. 주가 상승 모멘텀

- HBM 매출이 4분기 D램 매출의 40% 이상을 차지하며 고수익 구조가 강화됨.
- HBM4(12단) 2025년 하반기 양산 및 16단 2026년 양산 계획으로 차세대 리더십 가시화.
- 2024년 매출 66조 1,930억 원·영업이익 23조 4,673억 원으로 창사 최대 실적 달성 및 재무구조 개선.

2. 주가 하락 리스크

- 중국 공급사 영향으로 DDR4·LPDDR4 중심의 가격 하락 지속 가능성.
- 2025년 CAPEX 증가로 인한 투자 부담 확대.
- 중국 D램 업체의 DDR4·DDR5 시장 진입 시도에 따른 경쟁 심화 가능성.

3. 이번 콜 핵심 내용 한눈에 보기

3.1. 실적 변화 요인

- HBM 매출 비중 확대(4분기 D램 매출의 40% 이상)가 수익성 견인.
- AI 서버 투자 지속 및 일반 서버 교체 주기로 서버 D램 수요 견조.
- 영업외 수익 1.5조 원 반영(지분 처분 이익 및 외환 관련 이익).

3.2. 믹스/수주/가동/비용 등 핵심 드라이버

- HBM 중심 투자 집중으로 일반 D램 공급 증가 영향은 제한적.
- 1c 나노 개발 완료로 속도 28% 향상, 전력 효율 9% 이상 개선.
- HBM4 베이스 다이 성능 향상을 위해 TSMC와 원팀 체계 협업.

3.3. 다음 분기/향후 일정(모델/양산/투자/거점)

- HBM4(12단) 2025년 하반기 공급 목표.
- HBM4 16단 제품 2026년 양산 예상.
- 2025년 CAPEX는 HBM 물량 대응 및 M15X·용인 팹 건설 중심으로 확대 예정.

4. 실적 현황

4.1. 분기 실적 현황

- 4분기 매출 19조 7,670억 원
- 4분기 영업이익 8조 828억 원
- 영업이익률 41%

4.2. 사업부별 실적

- 4분기 기준 HBM 매출이 전체 D램 매출의 40% 이상 차지.

4.3. 실적 요약

- 2024년 연간 매출 66조 1,930억 원
- 영업이익 23조 4,673억 원(영업이익률 35%)
- 순이익 19조 7,969억 원(순이익률 30%)
- 창사 이래 최대 실적 달성(K-IFRS 기준).

4.4. 재무 현황

- 현금성 자산 14.2조 원
- 차입금 22.7조 원
- 순차입금 비율 12%
- 연간 고정 배당금 1,500원으로 상향
- 총 배당 규모 1조 원 수준으로 확대

5. 사업 추진 현황 및 전망

5.1. 시장 현황(업황)

- 중국 공급사 영향으로 DDR4-LPDDR4 가격 하락 존재.
- 하반기 AI 기기 출시 확대에 따라 DDR5 등 선단 제품 수요 증가 전망.
- 공급사들의 HBM 투자 집중으로 일반 D램 공급은 제한적.

5.2. 신사업 진행 상황

- HBM4(12단) 2025년 하반기 양산 목표.
- HBM4 16단 2026년 양산 예상.
- 1c 나노 개발 완료 및 향후 HBM4E 등 차세대 제품 적용 계획.

5.3. 투자 계획

- 2025년 CAPEX 전년 대비 증가 예정.
- 투자 대부분을 HBM, 미래 성장 인프라, R&D에 집중.

5.4. 생산/거점/내재화/증설 관련 내용

- M15X 및 용인 팹(Fab) 건설 추진.
 - HBM 베이스 다이 성능 향상을 위해 TSMC와 협업 체계 구축.
-

6. 회사 소개

6.1. 사업소개

- D램 및 HBM 등 메모리 반도체 사업 영위.

6.2. 밸류체인 및 고객사

- HBM4 베이스 다이 성능 향상을 위해 TSMC와 협업.

6.3. 핵심 경쟁력

- 1b 나노 양산 경험 기반 HBM4 개발.
- 1c 나노 공정 개발 완료(속도 28%·전력 효율 9% 이상 개선).
- 선단 공정 기술력에서 중국 업체 대비 격차 존재.

7. Q&A

Q. 레거시 제품 가격 하락 등 단기 시장 조정 전망은?

A. 중국 공급사 영향으로 DDR4·LPDDR4 중심 가격 하락이 있으나, 하반기 AI 기기 출시 확대로 DDR5 등 선단 제품 수요 증가 시 수급 균형이 가능하며, 공급사들의 HBM 투자 집중으로 일반 D램 공급은 제한적이어서 완만한 조정에 그칠 전망이다.

Q. HBM4 양산 일정 및 로직 파운드리 협업 현황은?

A. HBM4(12단)는 1b 나노 적용으로 개발 중이며 2025년 하반기 공급 목표, 16단은 2026년 양산 예상이며, 베이스 다이 성능 향상을 위해 TSMC와 원팀 체계로 협업 중임.

Q. 2025년 CAPEX 운영 방향은?

A. 고객과 협의된 HBM 물량 대응과 M15X·용인 팹 건설 등 인프라 투자로 전년 대비 증가 예정이며, 대부분 HBM·미래 성장 인프라·R&D에 집중되어 일반 D램 생산 증가는 제한적임.

Q. AI 트렌드가 추론으로 전환되면 HBM 수요가 줄어드나?

A. 고도화된 추론 및 AGI 구현에는 더 높은 메모리 용량과 대역폭이 필요하므로 추론 시장 확장은 고사양 HBM 성장의 중요한 요인이며, 국가 차원 AI 투자와 Physical AI 등장도 장기 성장 동력임.

Q. 1c 나노(6세대) 공정 개발 현황은?

A. 지난해 하반기 개발 완료했으며, 이전 세대 대비 속도 **28%**, 전력 효율 **9%** 이상 향상되었고 향후 **HBM4E** 등 차세대 제품에 적용 계획임.

Q. 중국 D램 업체 시장 진입에 대한 견해는?

A. **DDR4·DDR5** 시장 진입 시도가 있으나 선단 공정 기술력 격차가 존재하며, 대중 제재 강화로 선단 테크 개발에는 불확실성이 존재함.

Q. 영업외 수익 1.5조 원 발생 요인은?

A. **SK하이닉스시스템IC(우시) JV** 전환에 따른 지분 처분 이익 **1.3조 원**과 환율 상승에 따른 외환 관련 이익 **6천억 원** 등이 반영된 결과임.